

КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В АТОМАРНОЙ КИНЕТИКЕ

С. А. Решетняк, Л. А. Шелепин

Получение функции распределения заселенностей дискретных уровней атомарной плазмы имеет большое значение в задачах ионизации, рекомбинации, излучения плазмы, в теории ОКГ. В неравновесных условиях заселенности можно характеризовать квазистационарными распределениями, имеющими некоторые общие черты с распределением Тринора /1/ и его обобщениями в молекулярной кинетике /2,3/. Для получения таких распределений численные методы решения уравнений баланса /4,5,6/ неудовлетворительны в силу громоздкости, а методика броуновского движения в пространстве энергий /7,8/, будучи удовлетворительной для верхних уровней, не точна для нижних.

В данной работе получено аналитическое решение кинетических уравнений релаксации водородной плазмы, а при определенных упрощающих предположениях — любой атомарной плазмы. Это решение основано на разложении распределения в ряд по временным производным заселенности основного состояния. В принципе может быть аналитически вычислено любое приближение, однако в большинстве практически интересных случаев достаточно первого приближения.

Из элементарных процессов столкновений учитывались только соударения 1-го и 2-го рода атомов с электронами и не принимались во внимание другие маловероятные процессы. Кроме того плазма считалась оптически тонкой и пространственно однородной. Эти допущения позволяли записать систему уравнений для заселенностей дискретных уровней N_n водородной плазмы в одноквантовом приближении вначале без учета радиационного распада уровней следующим образом:

$$\frac{dN_n}{dt} = -V(n, n+1)N_n N_e + V(n+1, n)N_{n+1} N_e - V(n, n-1)N_n N_e + V(n-1, n)N_{n-1} N_e. \quad (I)$$

Здесь N_e - электронная плотность, v - вероятности соударений 1-го и 2-го рода электронов с атомами, усредненные по максвелловскому распределению электронов.

Для решения системы (1) была произведена замена переменных:

$$\tau = \int_0^t N_e(t') dt' \quad \text{и} \quad \frac{d\tau}{dt} = N_e. \quad \text{Легко показать, что заселенность}$$

m -го уровня может быть представлена в виде

$$N_m = \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_m^i N_1^{(i)}, \quad (2)$$

где α_m^i - некоторые постоянные величины, а $N_1^{(i)} = d^{(i)} N_1 / d\tau^i$. Подставляя (2) в (1) и используя принцип детального равновесия для прямых и обратных процессов, находили рекуррентные соотношения

$$\alpha_n^i = \sum_{m=i+1}^n \frac{n^2}{m^2} \frac{e^{-E_{n,m}/T_e}}{v(m, m-1)} \sum_{k=1}^{m-1} \alpha_k^{i-1}, \quad (3)$$

$$\alpha_k^0 = k^2 \exp(-E_{k,1}/T_e), \quad E_{n,m} = E_n - E_m, \quad i = 1, 2, \dots$$

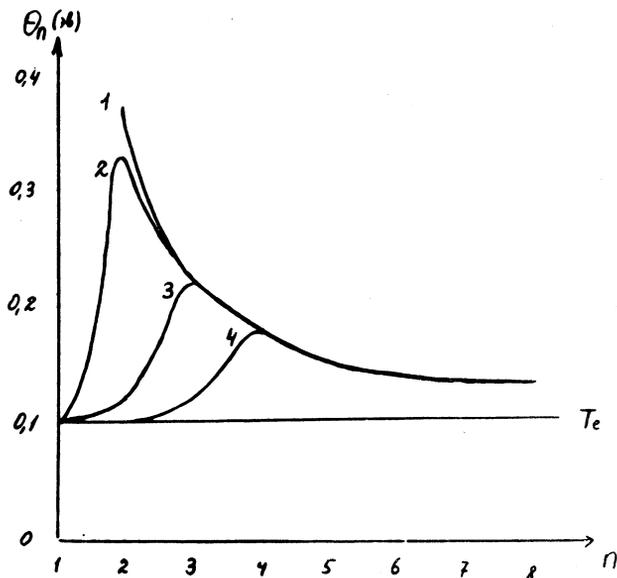
Решение (2) описывает процесс релаксации к больцмановскому распределению с температурой электронов T_e . Отклонение от больцмановского распределения дается членами с первой, второй и т.д. производными заселенности основного состояния атомов. Однако при рассмотрении "временного хвоста" релаксации можно ограничиться только членами с первой производной.

В этом приближении рассматривалась рекомбинация плазмы, степень ионизации которой превышает равновесную, соответствующую температуре свободных электронов $T_e = 0,05 \div 0,5$ эв. В работе были получены выражения для температур Θ_n между соседними уровнями n и $(n+1)$.

$$\Theta_n = \frac{T_e}{1 + \frac{T_e}{E_{n+1,n}} \ln \frac{1 + \alpha \beta_n}{1 + \alpha \beta_{n+1}}}, \quad (4)$$

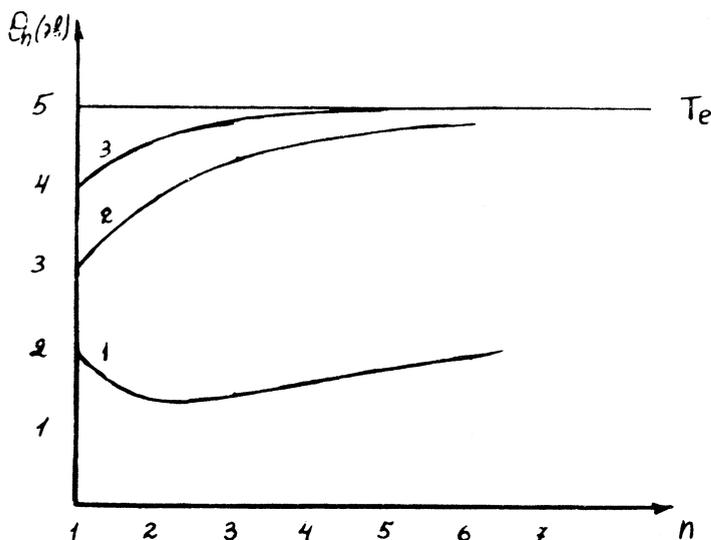
$$\alpha(\tau) = \frac{N_1^{(1)}}{N_1} = 4V(2,1) [\exp(-E_{2,1}/\theta_1) - \exp(-E_{2,1}/T_e)], \quad \beta_n^1 = \frac{\alpha_n^1}{\alpha_n^0} \quad (4)$$

Поскольку при рекомбинации заселенность нижнего уровня растет со временем, то параметр α положителен и стремится к нулю при $\tau \rightarrow \infty$. Результаты расчета по формуле (4) при фиксированном $T_e = 0,1$ эВ и различных значениях параметра α приведены в виде графиков на рис. 1. Вероятности соударений I-го и 2-го рода атомов с электронами брались из выражений, основанных на формуле Бете (см. /6/). Первая кривая на этом рисунке соответствует приближению "стационарного стока", так как характер распределения не зависит от значений $\alpha > 6,7 \cdot 10^{-52}$ ($\theta_1 > 0,102$). Вторая, третья и четвертая кривые со значениями $\alpha = 1,1 \cdot 10^{-52}, 10^{-57}, 10^{-59}$ соответственно показывают, через какую последовательность неравновесных распределений происходит процесс рекомбинации в плазме.



Р и с. 1. Квазистационарные распределения температур по уровням рекомбинирующей водородной плазмы.

В задаче об ионизации с $T_e = 5 \div 10$ эв в формуле (4) параметр \varkappa . наоборот, надо считать величиной отрицательной. На рис. 2 приведены результаты расчета неравновесных распределений в слу-



Р и с. 2. Распределения температур по уровням в задаче ионизации водородной плазмы.

чае ионизации плазмы при $T_e = 5$ эв и различных значениях θ_1 (или \varkappa). Вначале, когда T_e сильно отличается от θ_1 , ионизация идет довольно интенсивно. На этой стадии ионизации существенной оказывается роль многоквантовых переходов на верхних уровнях, поэтому первая кривая ($\theta_1 = 2$ эв) имеет недостаточный загиб к T_e . Начиная с момента, когда отличие T_e от θ_1 становится незначительным, заселенности определяются главным образом заселенностью соседнего нижнего уровня (ступенчатая ионизация). Характер релаксации распределения к равновесному состоянию на этой стадии отображен второй ($\theta_1 = 3$ эв) и третьей ($\theta_1 = 4$ эв) кривой.

Полученное распределение (4) сшивалось с распределением Саха для верхних уровней. Эта процедура, а также соотношения нормировки позволили найти условие пренебрежения членами со

второй производной, качественные временные зависимости $N_e(t)$, $N_1(t)$ и те допустимые значения параметра x , при которых можно рассматривать процессы релаксации.

В расчетах везде принималось $n_0 = 9$. Однако следует отметить, что характер распределения практически не зависит от значеий $n_0 > 9$.

При учете радиационного распада уровней в правой части кинетических уравнений (I) добавлялись два слагаемых, представляющие собой радиационные потоки с $(n + 1)$ -го уровня на рассматриваемый уровень n и поток с уровня n на все нижележащие. В случае "стационарного стока" /4/, когда N_e практически остается постоянной, или в квазистационарном случае, когда N_e меняется медленно, радиационный распад удается включить в общую схему решений системы (I) и получить рекуррентные соотношения для коэффициентов α_m^1

$$W(m + 1, m) \alpha_{m+1}^1 = V(m + 1, m) \alpha_m^1 + \sum_{n=1}^m \alpha_n^{i-1} + \frac{1}{N_e} \sum_{n=1}^m A(n) \alpha_{n+1}^1,$$

$$\alpha_1^0 = 1,$$

$$W(m + 1, m) = V(m + 1, m) + \frac{1}{N_e} A(m + 1, m), \quad (5)$$

где $A(n, m)$ - вероятность радиационного спонтанного перехода с

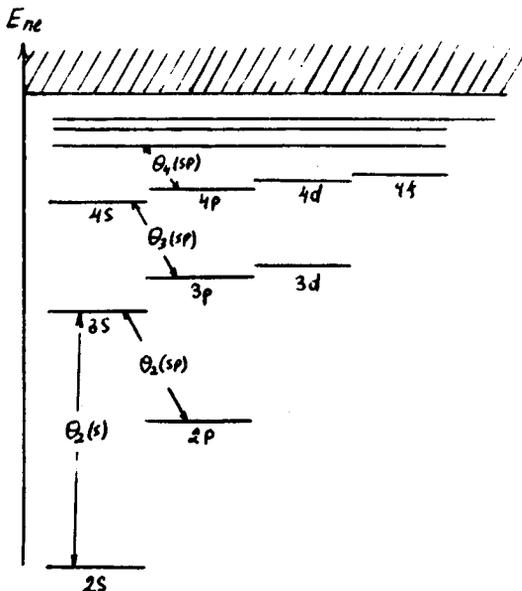
уровня n на уровень m , а $A(n) = \sum_{m=1}^{n-1} A(n, m)$. При этом формула для температур приобретает вид

$$\theta_n = \frac{E_{n+1, n}}{\ln \left[\frac{(n + 1)^2 \frac{\alpha_n^0 + \alpha_n^1 x}{\alpha_{n+1}^0 + \alpha_{n+1}^1 x}}{n^2} \right]}, \quad (6)$$

$$x = 4W(2, 1) \left[\exp(-E_{2, 1}/\theta_1) - \frac{V(2, 1)}{W(2, 1)} \exp(-E_{2, 1}/T_e) \right].$$

Если электронная плотность меняется быстро, то радиационный распад можно учитывать методом последовательных приближений, в котором на первом шаге в этих формулах нужно полагать N_e зависящим от времени.

В отличие от водорода структура дискретных уровней произвольных атомов имеет довольно сложный характер. Например, в случае атома лития уровень с главным квантовым числом n расщепля-



Р и с. 3. Схема уровней атома лития.

ется на подуровни с разными значениями орбитального числа l (см. рис. 3). Уравнения баланса, учитывающие неупругие столкновения атомов с электронами, имеют вид

$$\frac{dN_{nl}}{dt} = - N_e N_{nl} \sum_{n'l' \neq nl} V(nl, n'l') + \sum_{n'l' \neq nl} V(n'l', nl) N_{n'l'} N_e. \quad (7)$$

При решении (7) также делался переход к новой переменной τ . Далее, вводя предположение о бoльцмановском распределении по l и учитывая переходы с $\Delta n = 0, \pm 1$ и $\Delta l = \pm 1$, уравнения сводились к аналогичным уравнениям "задачи водорода" для заселенностей v -состояний. Решение этих уравнений искалось в виде ряда

$$N_{ns} = \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_n^i N_{2s}^{(1)}, \quad n = 2, 3, \dots \quad (8)$$

Для коэффициентов α_n^i возникали рекуррентные соотношения, из которых легко получить

$$\beta_m^1 = \frac{\alpha_m^1}{\alpha_m^0} = \sum_{n=2}^{m-1} \frac{1}{V(ns, n+1 p)} \left[1 + \sum_{k=3}^n \prod_{q=k}^n \frac{V(q s, q-1 p)}{V(q-1 s, q p)} \right],$$

$$m = 3, 4, \dots \quad (9)$$

Параметром, определяющим кинетику рекомбинации и ионизации, будет в этом случае температура $\theta_2(s)$ между уровнями $2s$ и $3s$. Наконец, выпишем формулу для температур между уровнями $(n+1)s$ и np

$$\theta_n(np) = \frac{E_{n+1,n}(s) - \Delta E_p(n)}{\frac{E_{n+1,n}(s) - \Delta E_p(n)}{T_e} - \ln \frac{1 + \beta_{n+1}^1 x}{1 + \beta_n^1 x}},$$

$$x = \frac{N_{2s}^{(1)}}{N_{2s}} = V(2s, 3p) \left\{ \exp \left[E_{3,2}(s) \left(\frac{1}{T_e} - \frac{1}{\theta_2(s)} \right) \right] - 1 \right\},$$

$$E_{n+1,n}(s) = E_{n+1s} - E_{ns}, \quad \Delta E_p(n) = E_{np} - E_{ns}. \quad (10)$$

Благодаря разветвлению релаксационного потока при рекомбинации плазмы ($x > 0$) может возникнуть инверсная заселенность для $(n+1)s - np$ переходов. Условие инверсности может быть легко получено из формул (10).

Результаты расчета населенностей в Li по указанным формулам находятся в хорошем соответствии с численным расчетом /9/ для релаксации в плотной литиевой плазме, а также в качественном согласии с результатами /10/ для атома гелия и /11/ для атома аргона.

Авторы выражают свою благодарность Б. Ф. Гордиенцу за полезное обсуждение работы.

Поступила в редакцию
3 февраля 1972 г.

Л и т е р а т у р а

1. С. В. Treanor, J. W. Eich, R. G. Rehm. *J. Chem. Phys.*, 48, 1798 (1968).
2. Б. Ф. Гордиец, А. И. Осипов, Л. А. Шелешин. *ЖЭТФ*, 59, 615 (1970); *ЖЭТФ*, 60, 102 (1971).
3. Н. Г. Басов, В. И. Игошин, Е. П. Маркин, А. Н. Ораевский. *Квантовая электроника*, 2, 3 (1971).
4. D. R. Bates, A. E. Kingston, R. W. P. Mc Whirter. *Proc. Roy. Soc.*, A 267, 297 (1962).
5. D. R. Bates, A. E. Kingston. *Planet. and Space Sci.*, 11, 1 (1963).
6. Б. Ф. Гордиец, Л. И. Гудзенко, Л. А. Шелешин. *ПМТФ*, № 6, 115 (1968); *JQSRT*, 9, 791 (1968).
7. А. В. Гуревич, Л. П. Пятаевский. *ЖЭТФ*, 46, 281 (1964).
8. Л. М. Биберман, В. С. Воробьев, И. Т. Якубов. *ЖЭТФ*, 56, 1992 (1969); *ТВТ*, 5, 201 (1967).
9. Б. Ф. Гордиец, Л. И. Гудзенко, Л. А. Шелешин. *ЖЭТФ*, 55, 942 (1968).
10. L. S. Jovan. *Phys. Rev.*, 155, 64 (1967).
11. Б. Ф. Гордиец, И. А. Дьмова, Л. А. Шелешин. *ЖПС*, 15, 205 (1971).